



## K. Memory (Design &amp; Process Technology) 분과

2019년 2월 14일(목), 11:00-12:30

Room A (아라홀, 2층)

## [TA2-K] Cross-point Array Technologies

좌장: 김 윤 교수(부산대학교), 유경창 수석(삼성전자)

TA2-K-1 11:00-11:15	Ge <sub>2</sub> Sb <sub>2</sub> Te <sub>5</sub> 상변화 메모리의 상태에 따른 간접적 상 분포 규명 방법 김귀현, 백승재 한경대학교 전기전자제어공학과
TA2-K-2 11:15-11:30	상장법(Phase-Field Method)을 활용한 상변화 물질 박막의 결정화 속도론 연구 허정화, 권용우 홍익대학교 신소재공학과
TA2-K-3 11:30-11:45	상변화메모리 동작 시 비정질과 결정질의 밀도 차에 의해 유발되는 기계적 응력에 대한 전산 해석 이환욱, 권용우 홍익대학교 신소재공학과
TA2-K-4 11:45-12:00	Ovonic Threshold Switching Phenomenon in Polycrystalline Zinc Telluride Thin Films Deposited by RF Sputtering System Taeho Kim, Dawoo Kim, Ingwan Lee, and Hyunchul Sohn Department of Materials Science and Engineering, Yonsei University
TA2-K-5 12:00-12:15	Threshold Switching Characteristics of Znte and 1S1R Application Gabriel Jang, Taeyoon Kim, Daseul Hyeon, and Jinpyo Hong Novel Functional Material and Devices Lab., Department of Physics, Hanyang University
TA2-K-6 12:15-12:30	Asymmetric Selector and Self-Limiting Current for High Density One Selector-One Resistor Crossbar Array Yumin Kim <sup>1,2</sup> , Young Jae Kwon <sup>1,2</sup> , Jihun Kim <sup>1,2</sup> , Cheol Hyun An <sup>1,2</sup> , Taegyun Park <sup>1,2</sup> , Dae Eun Kwon <sup>1,2</sup> , Hyo Cheon Woo <sup>1,2</sup> , Hae Jin Kim <sup>1,2</sup> , Jung Ho Yoon <sup>1,2</sup> , and Cheol Seong Hwang <sup>1,2</sup> <sup>1</sup> Department of Materials Science and Engineering, Seoul National University, <sup>2</sup> Inter-University Semiconductor Research Center, Seoul National University